



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 636011
FR 0308460

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
E	EP 1 398 829 A (CANON KK) 17 mars 2004 (2004-03-17) * colonne 12, alinéas 71,73,74 * * colonne 13, alinéas 76,78,79 * * colonne 14, alinéas 80,83; figures 4A-4J,5 *	1-22	H01L21/20 H01L21/762
X	US 6 191 007 B1 (MATSUI MASAKI ET AL) 20 février 2001 (2001-02-20) * colonne 43, ligne 47 - colonne 46, ligne 14 * * figures 35A-37 *	1-22	
Y	* colonne 47, ligne 4-40 * * figure 41C *	1-22	
Y	WO 93 01617 A (ASEA BROWN BOVERI) 21 janvier 1993 (1993-01-21) * page 4, ligne 2 - page 5, ligne 29 * * page 7, ligne 2,3 * * figures 1-3 *	1-22	
X	FR 2 781 082 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 14 janvier 2000 (2000-01-14) * page 13, ligne 19 - page 15, ligne 7 * * figures 2A-2C *	1,2, 4-14, 16-22	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7) H01L
A		3,15	
X	WO 00 48238 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE ;ASPAR BERNARD (FR); MORICEAU HUBERT) 17 août 2000 (2000-08-17) * page 22, ligne 3 - page 25, ligne 8 * * figures 7,8 *	1,2, 4-14, 16-22	
A		3,15	

	-/--		
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
29 mars 2004		Ekoué, A	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

1
EPO FORM 1503 12-99 (P04C14)



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 636011
FR 0308460

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2003/010445 A1 (YANAGITA KAZUTAKA ET AL) 16 janvier 2003 (2003-01-16) * page 6, alinéa 97 * * page 7, alinéas 110-112 * * page 8, alinéa 116 * * figures 1A-1E *	1,2, 12-14, 16-19,22	
A		3-11,15, 20,21	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 088 (E-490), 18 mars 1987 (1987-03-18) & JP 61 240629 A (NEC CORP), 25 octobre 1986 (1986-10-25) * abrégé *	1-22	
D,A	WO 01 97282 A (AUBERTON HERVE ANDRE ;S O I TEC SILICON ON INSULATOR (FR)) 20 décembre 2001 (2001-12-20) * abrégé *	1-22	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
29 mars 2004		Ekoué, A	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
<p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

1

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0308460 FA 636011**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 29-03-2004
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1398829	A	17-03-2004	EP 1398829 A2	17-03-2004
US 6191007	B1	20-02-2001	JP 10303139 A	13-11-1998
			JP 10308354 A	17-11-1998
			JP 3371756 B2	27-01-2003
			JP 10321549 A	04-12-1998
			JP 10335254 A	18-12-1998
			JP 11031825 A	02-02-1999
			JP 11097654 A	09-04-1999
			JP 11103034 A	13-04-1999
			JP 11111839 A	23-04-1999
			JP 11186186 A	09-07-1999
			JP 3458711 B2	20-10-2003
			JP 11087669 A	30-03-1999
			JP 11126910 A	11-05-1999
WO 9301617	A	21-01-1993	WO 9301617 A1	21-01-1993
FR 2781082	A	14-01-2000	FR 2781082 A1	14-01-2000
			EP 1103072 A1	30-05-2001
			WO 0003429 A1	20-01-2000
			JP 2002525839 T	13-08-2002
			US 2002089016 A1	11-07-2002
WO 0048238	A	17-08-2000	FR 2789518 A1	11-08-2000
			EP 1155442 A1	21-11-2001
			WO 0048238 A1	17-08-2000
			JP 2002536843 T	29-10-2002
US 2003010445	A1	16-01-2003	JP 2003017668 A	17-01-2003
			EP 1308999 A2	07-05-2003
JP 61240629	A	25-10-1986	JP 1934706 C	26-05-1995
			JP 6065210 B	22-08-1994
WO 0197282	A	20-12-2001	FR 2810448 A1	21-12-2001
			AU 6767601 A	24-12-2001
			CN 1436369 T	13-08-2003
			EP 1292975 A1	19-03-2003
			WO 0197282 A1	20-12-2001
			JP 2004503942 T	05-02-2004
			US 2003129780 A1	10-07-2003

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 61240629
PUBLICATION DATE : 25-10-86

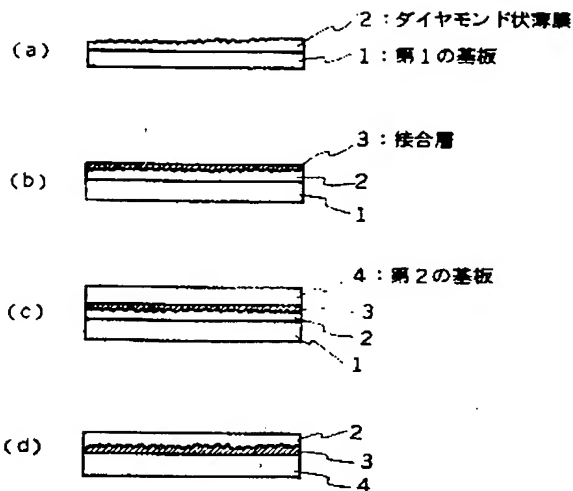
APPLICATION DATE : 17-04-85
APPLICATION NUMBER : 60081559

APPLICANT : NEC CORP;

INVENTOR : FUJII KAZUTAKA;

INT.CL. : H01L 21/205 H01L 21/304

TITLE : MANUFACTURE OF SUBSTRATE



ABSTRACT : PURPOSE: To obtain a substrate equipped with a diamond shape thin film having superior surface flatness, by jointing the second substrate, through a jointed layer, on the diamond shape thin film formed on the first substrate and then removing the first substrate.

CONSTITUTION: A silicon substrate 2 of 0.3mm in thickness is used as the first substrate 1 and a diamond-shape thin film 2 is deposited on it by exciting a mixing gas of CH_4 and H_2 with high frequency non-polar discharge with frequency of 13.56MHz. A jointed layer 3 is a material evaporation deposited and metallized with Ti, Pt; and Au. A silicon substrate of 0.3mm in thickness, which has been similarly metallized, is used as the second substrate 4 and jointed with an Au layer being fuse-bonded. The first substrate can be removed by grinding, however, the possibly remaining part of silicon, which can not be removed by grinding, is removed by well-known method.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio